09.03.04\_Программная инженерия(Очная)\_ПС В начало <u>Курсы</u> <u>ФИиВТ</u> 11\_Разработка программных систем <u>Тест К-2 2024</u> <u>(09.03.04\_11\_4 сем\_о)Физика</u> Раздел 2 "Основы физики твердого тела" **Тест начат** Понедельник, 20 Май 2024, 13:29 Состояние Завершенные **Завершен** Понедельник, 20 Май 2024, 13:45 Прошло 15 мин. 53 сек. времени Баллы 10,92/15,00 **Оценка 7,28** из 10,00 (**73**%) Вопрос 1 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже: Зоны разрешенных энергий валентных электронов относительно слабое влияние соседних атомов широкие потому, что испытывают... Зоны разрешенных энергий электронов, близких к ядру, относительно сильное влияние соседних атомов узкие потому, что испытывают... × Ваш ответ неправильный. **В**опрос **2** Частично правильный Баллов: 0,67 из 1,00

Электроны в металле при **T=0°К** обладают следующими свойствами:

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ Распределение электронов по состояниям описывается функцией 1/(exp((E-E<sub>f</sub>)/kT) + 1) ✓
- Распределение электронов по состояниям описывается функцией 1/(exp(E/kT) 1)
- Распределение электронов по состояниям описывается функцией exp(-E)/kT)
- Нет электронов с энергией, большей энергии Ферми
- ✓ Доля электронов с энергией, большей энергии Ферми, пропорциональна отношению (kT/E<sub>f</sub>)

×

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали слишком много вариантов.

Вопрос 3						
Верно						
Баллов: 1,00 из 1,00						
Средняя кинетическая энергия электронов в металле при комнатных температурах обычно много больше <i>кТ</i> . Объяснение этого связано с						
Выберите один ответ:						
⊚ принципом Паули ✔						
О корпускулярно – волновым дуализмом						
о расщеплением энергетических уровней						
О туннелированием электронов						
Ваш ответ верный.						
Вопрос 4						
Верно						
Баллов: 1,00 из 1,00						
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>n</i> – типа. <b>A B Г</b>						
Выберите один ответ:						
О донорный уровень						
<ul><li>валентную зону</li></ul>						
уровень Ферми при Т больше 0 К   ✓						
о зону проводимости						
○ уровень Ферми при T = 0 K						
Ваш ответ верный.						

Вопрос **5** Верно Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите верные утверждения для полупроводника р-типа:

Выберите один или несколько ответов:

- 🔲 Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны
- Уровень Ферми при Т = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий
- Уровень Ферми при Т = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔
- ✓ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✓

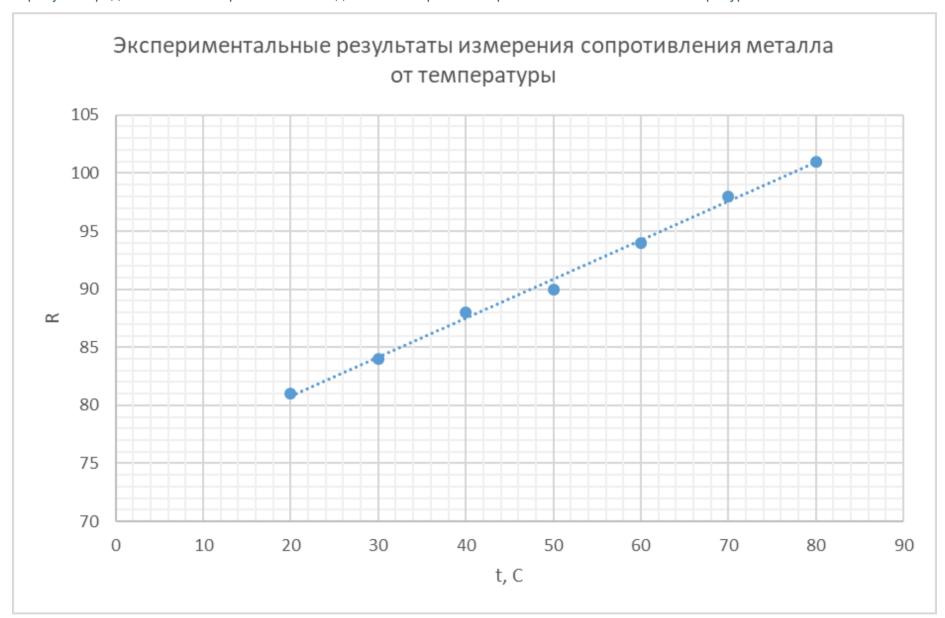
Ваш ответ верный.

Вопрос 6

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

На рисунке представлены экспериментальные данные измерения сопротивления металла от температуры:



Сопротивление R0 равно...

Ответ: 81

Вы не знаете определения величины R0!

**В**опрос **7** 

Частично правильный

Баллов: 0,75 из 1,00

При контакте двух разнородных металлов часть электронов из металла 1 перешла в металл 2

Потенциальная энергия металла 1 стала...

Энергия Ферми в металле 1 была ..

При таком переходе потенциал металла 1 стал...

Работа выхода у металла 1 ...

меньше	•
больше	•
меньше	
меньше	•

Ваш ответ частично правильный.

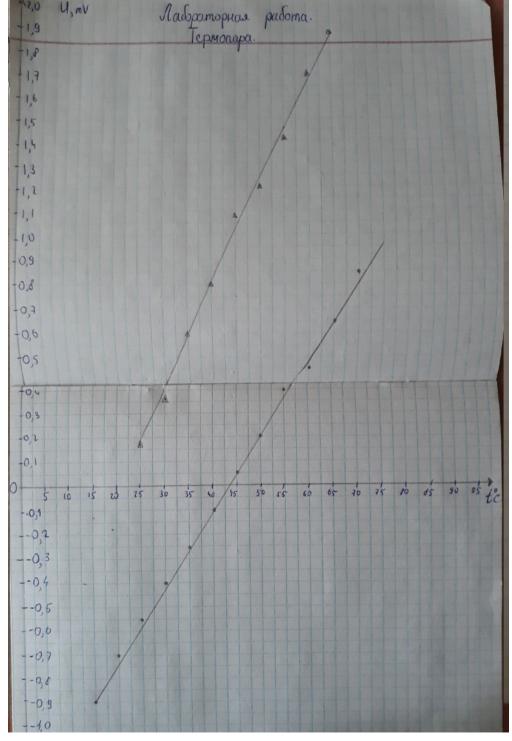
Вы правильно выбрали 3.

Вопрос 8

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

На рисунке показаны экспериментальные графики напряжения термопары от температуры:



Для нижнего графика (значения - точки) удельная термо-эдс (в мкВ/град) равна...

Ответ: 1

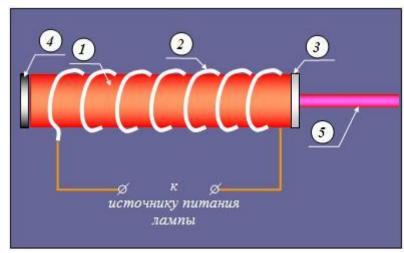
×

Вопрос 9							
Верно							
Баллов:	1,00 из 1,00						
p-n-п	ереход подключили к внешнему источнику тока, при	ıчем "+" присоеди	нили к р-г	полупроводнику, а	"-" к n-полупроводнику.		
Укажите последствия такого включения:							
Выберите один или несколько ответов:							
<b>~</b>	✓ уровень Ферми в n-полупроводнике будет выше, чем в p-полупроводнике						
<b>/</b>	ток <u>основных</u> носителей увеличится      ✓						
	ток неосновных носителей увеличится						
	тока <u>основных</u> носителей не будет						
	уровень Ферми в n-полупроводнике будет ниже, чем в p-полупроводнике						
Ваш ответ верный.							
Вопрос	10						
Верно	1,00 из 1,00						
Баллов.	1,00 из 1,00						
Прил	контакте 2-х типов полупроводников образовался р-	n-Geneyog					
	такту подключили внешний источник напряжения, п		0 <b>-</b> 000V000	ВОЛНИКУ "МИНУС" -	. к п-попупроволнику (прямое		
	чение).	ри юм <u>-плюо к</u> р	<u>5 11031 y 11 p 0</u>	<u>BOARIVINY, INVINTYO</u>	<u>- К н нолупроводнику (</u> примос		
Если	напряжение на контакте <u>увеличивать,</u> то при этом .						
Высс	ота контактного барьера будет <b>уменьшаться.</b>			да	~		
Число <u>неосновных</u> носителей, проходящих через барьер, будет <b>увеличиваться.</b>				нет	<b>✓</b>		
<u>Ширина</u> контактного барьера будет <b>уменьшаться.</b>				да	<b>✓</b>		
Числ	о <u>основных</u> носителей, проходящих через барьер, б	удет <b>увеличиват</b>	ъся.	да	<b>✓</b>		
Ваш ответ верный.							
Вопрос	11						
Верно							
Баллов: 1,00 из 1,00							
Проводник перешел в сверхпроводящее состояние. При этом							
Элек	троны перестали взаимодействовать с решеткой	нет	~				
Элек	лектроны стали обмениваться фононами да						
Элек	троны образовали куперовские пары	да	~				
Ваш	ответ верный.						

Вопрос 12	
Верно	
Баллов: 1,00 из 1,00	
Проводятся эксперименты с контактом Джозефсона. При этом	
Для стационарного эффекта Джозефсона выполняется закон Ома	нет
	✓
Энергия излучения в нестационарном эффекте Джозефсона равна <b>2eU</b>	да
	✓
Нестационарный эффект Джозефсона противоречит классической теории излучения энергии движущимис	да
зарядами	<b>✓</b>
Носители тока в контакте Джозефсона имеют заряд <b>-е</b>	нет
	<b>✓</b>
Ваш ответ верный.	
- 42	
Вопрос <b>13</b> Частично правильный	
Баллов: 0,50 из 1,00	
Составьте верные утверждения:	
Энергетический уровень называется <b>метастабильным</b> , если переходы с него в идеальном случае	запрещенными
ляются	
Если время жизни молекул в возбужденном состоянии составляет порядка нескольких <i>наносекунд</i> , то	метастабильным
такой уровень называется	
Ваш ответ частично правильный.	
Вы правильно выбрали 1.	
DE TIPADE DE LO DE LO PARTE LE	

Вопрос 14 Верно

Баллов: 1,00 из 1,00



На рисунке представлена структура лазера:

Приведите в соответствие название элемента и его номер:

Зеркало 4 Полупрозрачное зеркало 3 Активная среда 1 Накачка 2

Ваш ответ верный.

Вопрос **15** 

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00



Приведите в соответствие следующие утверждения:

Вынужденное излучение происходит между уровнями ...

Метастабильный - это уровень ...

Накачка - это переход между уровнями ...

E2 - E1 E2

1 - 3

Ваш ответ верный.